

Désignation	Fréquence d'utilisation	Gérée par (Maintenance, Formation)	Type	Date d'achat	Etat	Evolution lors des dernières années
<b>1 - TEST PARAMETRIQUE</b>						
1.1 Caractérisation standard	Quotidienne	2i	Assemblée	>10 ans	Vieux mais OK	Non
1.2 Caractérisation bas niveau	Quotidienne	2i	Assemblée	<10 ans	Très bon	Oui
1.3 Caractérisation des composants de puissance	Quotidienne	2i	Assemblée	<5 ans	Très bon	Oui
1.4 Traceurs de caractéristiques I(V)	Hebdomadaire	2i	Appareil unique	<10 ans	Très bon	Non
1.5 Test aux décharges électrostatiques : TLP	Quotidienne	2i	Développée au LAAS	<5 ans	Très bon	Oui
<b>2 - MESURE D'IMPEDANCE</b>						
2.1 Mesure de capacités inter-électrodes de MOS	Rare	2i	Développée au LAAS	<10 ans	Très bon	Non
2.2 Mesure RLC dans la gamme 20Hz <f< 1MHz	Quotidienne	2i	Développée au LAAS	<10 ans	Très bon	Non
2.3 Mesure RLC dans la gamme 75kHz <f< 30MHz	Variable	2i	Assemblée	<10 ans	Très bon	Non
2.4 Mesure C(V) avec Sonde au Mercure	Variable	2i	Assemblée	>10ans	Vieux mais OK	Oui
<b>3 - OBSERVATION DE MICRO/NANO SYSTEMES</b>						
3.1 Microscope à force atomique (AFM)	Quotidienne	M. Dilhan	Appareil unique	<1 an	Neuf	Oui
3.2 Profilomètre optique par interférométrie	Quotidienne	NANO	Appareil unique	<1 an	Neuf	- (neuf)
3.3 Observation par binoculaire	Quotidienne	2i	Appareil unique	<10 ans	Très bon	Non
3.4 Caractérisation par déflexion optique de la réponse dynamique de microstructures mécaniques	Quotidienne	NANO	Développée au LAAS	<5 ans	Très bon	Oui
3.5 Microscope à force atomique et microscope optique inversé	Quotidienne	NANO	Appareil unique	<5 ans	Très bon	Oui
3.6 Table X,Y,Z,θ pour l'étude de dispositifs de micro-dépôts, de nano-stamping, et de profilométrie en micro-cavités profonde	Quotidienne	JB Pourciel	Développée au LAAS	<5 ans	Très bon	Oui
<b>4 - LOCALISATION/MESURE DE POINTS CHAUDS</b>						
4.1 Mesure de photoémission	Hebdomadaire	2i	Appareil unique	<5 ans	Très bon	Oui
4.4 Thermographie Infrarouge rapide (caméra Cedip)	A voir	2i-TMN	Appareil unique	<1 an	Neuf	- (neuf)
<b>5 - CARACTERISATION DE SUBSTRATS</b>						
5.1 Mesure de durée de vie des porteurs	Très rare	TMN	Appareil unique	<10 ans	Très bon	Non
5.2 DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy)	Rare	TMN	Appareil unique	<10 ans	Très bon	Non
5.3 Mesure par Effet Hall	A voir	2i	Appareil unique	<1 an	Neuf	- (neuf)
<b>6 - CARACTERISATION DE COMPOSANTS DISCRETS / MICROSYSTEMES</b>						
6.1 Caractérisation de micromiroirs	Quotidienne	MIS	Développée au LAAS	<5 ans	Très bon	Oui
6.2 Mesure de paramètres de transistors MOS	Variable	2i	Développée au LAAS	<10 ans	Très bon	Oui
<b>7 - BANCS DE MESURE AYANT DISPARU</b>						
Mesure de temps de commutation de MOS	N/A	CIP	Développée au LAAS		Banc inexistant	
Mesure de paramètres de transistors bipolaires	N/A	TMN	Développée au LAAS		Banc inexistant	
Mesure de paramètres de diodes	N/A	TMN	Développée au LAAS		Banc inexistant	
Réponse thermique transitoire par thermométrie IR (µscope IR Barnes)	N/A	CIP	Appareil unique		Bon	
Pompage de charges	N/A	TMN	Développée au LAAS		Banc inexistant	